6)酸化チタンコーティング剤の改良と環境浄化への応用

一ノ瀬 弘 道

金属ドープペルオキソ改質アナターゼゾルの合成とその特性

NbおよびV含有ペルオキソチタン酸水溶液を100 で水熱反応させることにより水中に良好に分散したNbおよびVドープアナターゼ超微粒子を作成した。Nbをドープするとアナターゼの格子定数が増大し、添加量の増大に伴い紡錘状から短冊状、立方体状へと変化したが、光吸収スペクトルの変化はなかった。VをドープするとC軸の格子定数が減少し、結晶が微細化し、光波長350-700nmの範囲で吸光度が増大した。

1. はじめに

TiO2は光触媒、センサー、太陽電池などの材 料として重要であり、とくに、その膜はゾルゲル 法や固相反応によって研究されてきた。最近、金 属アルコキシドや塩化物を出発原料とした共沈法 によるNb及びVドープTiO2が触媒、センサー用 に合成されている^{1,2)}。一方、アナターゼ超微粒 子が水中に均一分散したペルオキソ改質アナター ゼゾルは、ペルオキソチタン酸水溶液などを水熱 結晶化させることによって得られる^{3,4)}。もし、 金属とペルオキソチタン酸水溶液の均一溶液が得 られれば、高温に加熱することなく、水熱するこ とによって金属ドープアナターゼ超微粒子ゾルが 得られることが期待される。しかし、ペルオキソ チタン酸水溶液に金属イオンを添加するとゲル化 凝集が起こる。Nb及びVはペルオキソ化合物を生 成することが知られており、均一溶液を得ること ができる可能性がある。また、一般に、超微粒子 への水熱結晶化に不純物濃度が大きく影響を及ぼ すことが分かっている。本研究では、アナターゼ ゾルの結晶化に及ぼす不純物濃度の影響を明らか にし、また、Nb及びV含有ペルオキソチタン酸水 溶液を合成し、それを水熱して得られるアナター ゼゾルのキャラクタリゼーションを行なった。

2. 実験方法

出発原料として、Ti粉末 (Ti > 98%)、Nb粉末 (Nb>99.5%)、塊状V(V>99.5%)を使用した。 まず、アンモニア水 (3 mol/dm) 15m と過酸化 水素水 (30mass%) 65mlの混合溶液に0.01molの Ti粉末を投入し、数時間で完全に溶解させた。次 に、陽イオン交換樹脂によってアンモニウムイオ ンを所定の濃度まで除き、最終的に0.1mol / dm のペルオキソチタン酸水溶液を得た。さらに、こ のペルオキソチタン酸水溶液を100 で8時間水 熱し、ペルオキソ改質アナターゼゾルを作成した。 同様の方法でNbとVドープされたペルオキソ改質 アナターゼゾルを合成した。得られたゾルを乾燥 した粉末を用いてX線回折、BET比表面積測定装 置、FT-IR、紫外可視分光光度計などによって特 性評価した。アンモニウムイオンの定量は、イン ドフェノール法で行なった。

3. 結果と考察

(1) 結晶化最適アンモニウムイオン濃度

異なった濃度のアンモニウムイオンを含むペル オキソチタン酸水溶液を100 、8時間加熱した 液体のFT-IRスペクトルを図1に示す。アンモニ ウムイオン濃度が0.021mol / dm³以上の場合、フ リー過酸化物 (O-O、1次結合)の伸縮モードが



図1 異なった濃度のアンモニウムイオンを含む ペルオキソチタン酸水溶液を100℃8時間 加熱した液体のFT-IRスペクトル.

890cm⁻¹で検出された。このことは、ペルオキソ 錯体がアンモニウムイオンの安定化効果によって 水熱後も残存していることを示すものである。 3200~3400cm¹のブロードなピークと1630cm¹の 鋭いピークは水分子に起因する吸収である。1400 cm⁻¹のピークはアンモニアのN-H結合の伸縮振 動に起因するものである。図2にそれらのX線回 折パターンを示す。0.014mol / dm 以下でアナター ゼ相のみが検出された。すなわち、ペルオキソチ タン酸水溶液からアナターゼへのスムーズな結晶 化のためには、アンモニウムイオン濃度を0.014 mol/dm[®]以下にしなければならないことが判明 した。しかし、アンモニウムイオン濃度が0.0063 mol/dm 以下のペルオキソチタン酸水溶液は時 間と共に高粘性になり、ついにはジャム状になり 分散性が高いアナターゼゾルを作るには不適当で あった。結局、アナターゼゾルを作成するのに最 適なアンモニウムイオン濃度は0.0063~0.014mol /dm[®]であった。この結果より、以後の実験はア ンモニウムイオン濃度0.01mol / dm[®]で行なった。



図2 異なった濃度のアンモニウムイオンを含むペル オキソチタン酸水溶液を100℃8時間加熱した 液体の乾燥粉末のX線回折パターン.

(2) Nb、Vドープアナターゼゾルの特性

NbとVを2、5、10mol%添加したペルオキソ チタン酸水溶液を100 で8時間水熱したものは すべてアナターゼへ結晶化し、溶媒中へ均一に分 散した。これらのアナターゼゾルは半透明で長期 間安定であった。そのアナターゼ粒子のTEM写 真を図3に示す。ドーピングしない場合、紡錘状 あるいは矢尻状のアナターゼ結晶であった。Nb の添加量が増大するに伴ってそのアスペクト比が 小さくなり、Nbを10mol%添加すると立方体状に なった。電子線回折分析によれば、結晶面のほと んどはアナターゼ(101)であった。一方、Vを ドープするとアスペクト比と結晶子の大きさが小 さくなった。10mol%V添加の結晶サイズは5~ 8 nmであった。図4 に金属ドープペルオキソ改 質アナターゼゾルの比表面積を示す。比表面積は 未ドープの場合165m²/gであったが、Nbドープ では添加量とともにやや小さくなり、Vドープで は2 mol%添加で210 m²/gに増大したが、それ 以上ドープしても比表面積はそれほど大きくなら







図4 金属ドープアナターセゾルの比表面積



図5 金属ドープアナターセゾルの格子定数



- 図3 NbとVドープアナターゼゾルのTEM写真 a) 未ドープ, b) N b 2 mol%, c) N b 5 mol% d) N b 10mol%, e) V 2 mol%, f) V 5 mol%

 - g) V10mol%



図6 金属ドープアナターゼ乾燥粉末の拡散反射スペクトル

なかった。

NbとVドープアナターゼの格子定数を図5に 示す。未ドープの場合、標準の格子定数とよく一 致し、Nbドープにしたがって徐々に増大した。 Vドープの場合は、添加量の増大とともに c 軸が 減少したが、a軸はほとんど変化しなかった。V ドープしたアナターゼゾルの乾燥粉末の光吸収ス ペクトルを図6に示す。Vドープしたアナターゼ は350nm以上で光吸光度が増大した。また、吸収 端が長波長側へシフトしたためアナターゼ結晶中 に不純物準位が形成されたことが示唆された。し かし、Nb添加では光吸収スペクトルの変化はほ とんどなかった。さらに、XPSによるNbとVの 化学結合状態の分析結果を図7に示す。NbとV は共に5価として存在するものが支配的であるこ とが判明した。過去の報告によれば、Nbを0.6mol %以上添加して700 で加熱すると格子定数の増 大を伴いながら侵入型の固溶体を形成するという ことが示されている⁵⁾。したがって、本研究の場 合もNbは侵入型の固溶体を形成していると考え られる。また、V⁵⁺ (r=0.054nm) はTi⁴⁺ (r= 0.061nm)よりも小さいため、格子定数の減少を 伴った置換型の固溶体を形成すると考えられる。

しかし、それら金属イオンの正確な固溶量を明確 にすることはできなかった。

一方、これらの5価金属ドープアナターゼゾル の光触媒活性は未ドープのそれよりも低いことは 容易に推定できるが、その変化を確認するために、 その乾燥粉末をガラスに塗布した膜(面積10cm)、 TiO₂: 2 mg / cm²) とBLBランプの紫外線 (0.5 mW / cm³) によるイソプロパノールガス (100ppm, 1300ml)からアセトンガスへの光触媒酸化反応速 度を測定した。その結果を図8に示す。未ドープ の場合の反応速度が一番速く、Nbドープすると 反応速度が半減し、Vドープの場合は非常に遅く なり僅かな酸化反応が起こる程度であった。Vドー プの場合は紫外可視分光スペクトルから分かるよ うに不純物準位が生成していることが推定され、 そのサイトが電荷分離された電子正孔ペアの再結 合センターになっているという従来の結果と同じ 現象が起きていると考えられる。



図7 金属ドープアナターゼ薄膜中のNb3d5/2とV2p3/2の束縛エネルギースペクトル化学シフト

4. まとめ

本研究では、ペルオキソチタン酸水溶液を利用 したNbおよびVドープペルオキソ改質アナター ゼゾルの合成を低温で達成することができた。こ のことは、前駆体であるNbおよびV含有ペルオ キソチタン酸水溶液が均一であることを示唆する ものである。また、ゾル中の結晶の形態や格子定 数等はドープ量によって大きく変化することが判 明した。これらのNbおよびVを含む均一なペル オキソチタン酸水溶液とペルオキソ改質アナター ゼゾルは触媒やセンサー材料として今後期待され る。

参考文献

- 1) J. Kiwi et al., Chem. Phys. Lett., 106, 135 (1984).
- 2) S. T. Martin et al., J. Phys. Chem. 98, 13695 (1994).
- 3) H. Ichinose et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 104, 715 (1996).
- 4) H. Ichinose et al., J. Sol-Gel Sci. Tech. 22, 33 (2001).
- 5) 菱田ら, 窯業協会誌, 91, 399 (1983).



図8 金属ドープアナターゼ薄膜の紫外線照射による イソプロパノールガスからアセトンガスへの酸 化運動 酸化チタンコーティングシリカゲルの光触媒活性 (実用化支援)

光触媒水処理材料の実用化を目的として、ペルオキソ改質アナターゼゾルをコーティングしたシリカ ゲルを作成し、循環水系脱色試験によって光触媒分解性能を評価した。

1. はじめに

光触媒シリカゲルは産総研の技術として既に製 品化されており、焼却炉排ガス中のダイオキシン の分解や水処理などに利用されている¹⁾。シリカ ゲル細孔内や表面の酸化チタンコーティング法と してはゾルゲル法が一般的に用いられている。こ の実験では、水系の脱色実用化を目的として、ペ ルオキソ改質アナターゼゾルを塗布したシリカゲ ルの光触媒分解性能を調べた。

2. 実験方法

シリカゲルは(剤ダイヤカセイ社製Bタイプ球状 シリカゲル(平均細孔径約6-7nm、直径2-3mm)を用い、光触媒として0.1mol/dm[®]のペル オキソ改質アナターゼゾルを用いた。希アンモニ ア水にシリカゲルを浸漬して洗浄したシリカゲル をアナターゼゾル中に3時間浸漬し、60 で6時 間乾燥した。この操作を3回繰り返した。TiO2 としての含有量は0.5mass%であった。このシリ カゲルを図1のような幅4cm×40cm×2列の箱型 アクリル反応容器内に敷き詰め、10ppmインジゴ カルミン水溶液1dm[®]を0.1dm[®]/minで循環しなが ら、BLBライトで1mW/cm[®]の紫外線を照射した。 610nmで循環液の吸光度を測定して分解率を測定 した。



図1 光触媒脱色反応装置概念図



 $20 \,\mu$ m

図2 ペルオキソ改質アナターゼゾルを塗布した シリカゲル表面 a)前処理なしシリカゲル

b)希アンモニア水侵洗浄シリカゲル

3.研究報告

3. 結果

シリカゲルの断面をEPMAによって元素分析し たが、酸化チタンはシリカゲル表面にのみ高濃度 に存在し、内部には確認できなかった。シリカゲ ルの平均細孔径は6 - 7 nmであるため、ペルオ キソ改質アナターゼゾルの結晶 (10nm) は細孔 内に入り込むことができなかったと考えられる。 シリカゲル表面の酸化チタンのSEM写真を図2 に示す。ペルオキソ改質アナターゼゾルに直接シ リカゲルを浸漬して作成したものは、シリカゲル 表面に不均一な酸化チタンの塊が至るとことに付 着しており、酸化チタンが均一にコーティングす ることができなかった。一方、希アンモニア水に シリカゲルを浸漬して洗浄したものにコーティン グした場合は、均一なコーティング膜が形成され ていた。この違いは、ペルオキソ改質アナターゼ ゾルが酸性を示すシリカゲル表面で瞬時にゲル化 しているためである。

図3にインジゴカルミンの青い色素の吸光度と 紫外線照射時間の関係を示す。シリカゲルの量を 加減して、反応槽におけるシリカゲルの厚みを0.5、 1、2 cm (それぞれ、シリカゲル170ml, 340ml, 680ml) と変化させてみたところ、1 cmと2 cmの 厚みではさほど大きな脱色速度の違いは見られな かった。本実験の紫外線強度では、それ以上の深 さまでは紫外線が通り難いことが原因と考えられ る。また、シリカゲルへの色素の吸着率の違いに よって脱色速度が大きく異なった。たとえば、図 4のように10ppmメチレンブルー水溶液中に本実 験で調整した光触媒シリカゲルを投入して日光下 に放置すると、まずメチレンブルーのシリカゲル 中への吸着が短時間で起こり、その後に吸着され たメチレンブルーが脱色された。インジゴカルミ ンのシリカゲルへの吸着は比較的弱く、主に光触 媒作用によって水溶液が脱色された。つまり、効



図3 光触媒シリカゲルによるインジゴカルミン 10ppm水溶液の分解挙動



図4 光触媒シリカゲルのメチレンブルー(MB) 吸着と日光による光触媒分解。MB濃度:10ppm

率よく分解するには、処理する有機物の性状にあ わせた材料設計が必要であることが示唆された。

4. まとめ

実用化を目的とした予備実験として、ペルオキ ソ改質アナターゼゾルをコーティングしたシリカ ゲルを用いて色素水溶液の脱色を行なった。今後、 反応速度を向上させるために光触媒担体内部への コーティグ方法、反応装置の構造等の改善を図る 予定である。

謝辞

シリカゲルを提供していただいた有限会社ダイ ヤカセイ様に深く感謝の意を表します。

参考文献

たとえば、垰田、トコトンやさしい光触媒の
本、日刊工業新聞社 (2002).